

สุชาติณี สมบูรณ์ทรัพย์ 2556: การสังเคราะห์ฟิล์มโคบอลต์-ทองแดงแบบแกรนูลาร์ สำหรับประยุกต์เป็นเซนเซอร์ทางแม่เหล็ก ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก:  
อาจารย์วัชร รัตนสกุลทอง, ปร.ด. 106 หน้า

งานวิจัยนี้เตรียมฟิล์มโคบอลต์-ทองแดงที่ระยะเวลาเคลือบและอัตราส่วนต่าง ๆ ด้วยเทคนิคสเปตเตอร์ริงบนฐานรองแก้วและโพลีเอไมด์ โดยศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้าง แม่เหล็ก ความร้อน พื้นผิว และปรากฏการณ์จีเอ็มอาร์ของฟิล์ม สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์ทางแม่เหล็ก ฟิล์มโคบอลต์-ทองแดงที่ระยะเวลาเคลือบต่าง ๆ ทั้งบนฐานรองแก้วและโพลีเอไมด์ มีโครงสร้างเฟสสารละลายของแข็ง  $\text{Co}_{52}\text{Cu}_{48}$  ในระนาบ (111), (200) และ (220) และแสดงสมบัติแม่เหล็กแบบพารา โดยพบปรากฏการณ์ MR ขนาด 0.29% ในฟิล์มโคบอลต์-ทองแดงบนฐานรองโพลีเอไมด์ที่ระยะเวลาเคลือบ 40 นาที ฟิล์มโคบอลต์-ทองแดงที่อัตราส่วนต่าง ๆ ทั้งบนฐานรองแก้วและโพลีเอไมด์มีโครงสร้างเฟสของ Co (HCP) และ Cu (FCC) ในระนาบ (111) และแสดงสมบัติแม่เหล็กแบบเฟอร์โรในตัวอย่างที่มีอัตราส่วน Co ประมาณ > 34% โดยฟิล์มโคบอลต์-ทองแดงที่มีอัตราส่วน Co < 34% จะแสดงสมบัติแม่เหล็กแบบพารา และพบปรากฏการณ์ GMR ขนาด 0.09% ในฟิล์ม  $\text{Co}_{42.64}\text{Cu}_{57.36}$  บนฐานรองโพลีเอไมด์ จากการเปรียบเทียบการเคลือบของฟิล์มบนฐานรองแก้วและโพลีเอไมด์ พบว่าอัตราการเคลือบฟิล์มโคบอลต์-ทองแดงบนฐานรองโพลีเอไมด์มีอัตราการเคลือบสูงกว่าบนฐานรองแก้ว โดยความหนาของฟิล์มที่ระยะเวลาเคลือบต่าง ๆ บนฐานรองแก้วมีค่าระหว่าง 0.551-2.53  $\mu\text{m}$  และบนฐานรองโพลีเอไมด์มีค่าระหว่าง 25.2-64.2  $\mu\text{m}$ . นอกจากนี้พบว่า ความขรุขระของพื้นผิวบนพื้นที่สแกน 1  $\mu\text{m}^2$  ของฟิล์มบนแก้วมีค่าประมาณ 0.551-2.53 nm และบนโพลีเอไมด์มีค่าประมาณ 0.66-2.28 nm และความต้านทานไฟฟ้าของฟิล์มบนฐานรองแก้วและโพลีเอไมด์มีค่าระหว่าง 0.279-1,800 โอห์ม และ 0.426-9.895 โอห์ม ตามลำดับ